

日程表（分科別Ⅰ）

大分類分科名 中分類分科名	2020年3月12日(木)		2020年3月13日(金)		2020年3月14日(土)		2020年3月15日(日)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
S シンポジウム								
NT1【一般公開】応用物理分野におけるダイバーシティ推進を通じた次世代人材育成—学会としてできること／すべきこと—				A304 13:30～18:00				
NT2【一般公開】就活生必見！車は半導体でできている！～車載半導体の未来と最先端研究者の「やりがい」～			A307 10:00～12:10					
NT3【一般公開】応用物理技術の社会実装の加速を目指して～集積回路技術を例題に～					A304 13:30～17:30			
T1【一般公開】ポストムーア時代を切り拓くアーキテクチャと革新デバイス/システム				A307 13:30～17:10				
T2「気付き」と「学び」と「環境・エネルギー」					D419 14:00～16:40			
T3 植物RIイメージング技術と応用～農業応用の最前線～				A501 13:15～16:45				
T4 光ニューラルネットワーク計算技術の新潮流		B414 13:00～16:45						
T5 レーザー誘起ナノ周期構造の研究の現状～どこまで分かっているのか？技術の展望はあるのか？				B410 13:30～18:00				
T6 量子コンピュータ開発のための応用物理				B414 13:30～17:30				
T7 空間光変調技術の基礎と応用					B410 13:30～17:30			
T8 THz 赤外帯フォトニクス応用展開を志向したナノ材料科学					B414 10:00～12:05	B414 13:30～17:05		
T9 揺らぐ媒質を伝搬する光の乱れの理解とその克服							B409 09:00～12:10	
T10 全固体電池の最前線：基礎、課題、将来展望				A410 13:30～17:00				
T11 量子ビームによる表面物性・構造解析の新展開				D215 13:30～16:45				
T12 機能性酸化物のメモリデバイス応用とその物理解明に向けて					A401 09:15～11:55	A401 13:30～15:30		
T13 多次元計測技術とデータサイエンスの融合によるバイオイメージング・センシングの将来						A408 13:30～18:00		
T14 遷移金属化合物薄膜の光機能の量子ビームによる探究			D311 09:00～12:00	D311 13:45～16:15				
T15 EUV・軟X線イメージングの描く未来						D305 13:30～17:20		
T16 プラズマ誘起生体反応の機序解明最前線～何が何処まで解ってきたか～				A205 13:30～17:20				
T17 アンサンブル現象の融合科学 ～複合状態の調和が織りなす機能創発と応用～						A409 13:30～17:30		
T18 エナジーストレージ素子の最前線 ～大容量・高信頼性に向けて～				A402 13:30～17:55				
T19 熱・電気物性測定の新技術と課題				D511 13:30～16:55				
T20 不揮発性メモリ技術の最前線 - スピンから相変化型、抵抗変化型、強誘電体まで本音で議論				A301 13:30～17:15				
T21 超伝導が可能にするセンシング技術～SQUIDの最新応用展開～						D411 13:30～17:35		
T22 有機トランジスタ：新たなフロンティアを目指して						A410 13:30～18:30		
T23 多様な安定相のエンジニアリングによる多元系材料開発の新展開 - 未来材料開拓イニシアチブ ～環境・エネルギー材料の未来～	A301 10:00～12:00	A301 13:30～17:15						
T24 生産現場での活用が進むIoTデバイス技術		A410 13:30～16:45						
T25 先端イオン顕微鏡技術の近年の進歩：ナノ材料・デバイスへの展開				A303 13:30～17:15				
T26 窒化物半導体特異構造の科学 ～実験と理論の接点を探る：物性解明と制御～		A307 13:30～17:30						
T27 低温（常温）接合界面及び薄膜成長界面ナノ・キルネテス（舵手）					A201 09:00～12:15	A201 13:45～17:20		
T28 超スマート社会のためのエネルギーハーベスティングの展開			A301 09:00～12:20					
T29 非晶質材料の動的現象とデバイス応用の現状と展望				A201 13:30～17:30				
T30 太陽電池を例としたモジュール科学の学理構築に向けて						A402 13:30～18:00		
T31 二次元集積科学：二次元材料とその集積化がもたらす新たな学理と応用				A401 13:30～18:30				
TU チュートリアル								
TU1 ドライブプロセスによる薄膜作製のための真空技術～基礎から応用まで～（中野 武雄）	D411 09:00～11:30							
TU2 超高分解能角度分解光電子分光と新機能物質の電子構造解明（佐藤 宇史）			D411 09:00～11:30					
TU3 製造業におけるAI技術適用と機械学習の基礎（守屋 剛、狐塚 正樹）	A205 09:00～12:10							
TU4 注目の新素材ナノセルロース～作製方法・基礎物性から最新応用事例まで～（古賀 大尚）		D305 13:30～16:00						
TU5 スピントロニクス入門（高梨 弘毅）	A501 09:00～12:10							
TU6 グラフェンと2次元物質の基礎と2020年代の重点課題（齋藤 理一郎）		A401 13:30～16:00						
CS コードシェアセッション								
CS.1 3.5 レーザー装置・材料、3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション		B508 16:45～17:30						
CS.2 3.11 フォトリソグラフィ・現象と3.12 ナノ領域光学・近接場光学のコードシェアセッション							B415 13:15～16:15	
CS.3 3.11 フォトリソグラフィ・現象と3.13 半導体光デバイスのコードシェアセッション							B415 09:30～12:00	
CS.4 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア						A303 13:45～17:30		
CS.5 7.4 量子ビーム界面構造計測、9.5 新機能材料・新物性のコードシェアセッション					D215 09:30～11:45	D215 13:45～15:45		
CS.6 8.3 プラズマナノテクノロジーと9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシートと13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェア		D511 13:45～17:15						
CS.7 10.1 新物質・新機能創生（作成・評価技術）、10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術、10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術、10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関のコードシェア						A501 15:45～19:00		

日程表（分科別Ⅱ）

大分類分科名 中分類分科名	2020年3月12日(木)		2020年3月13日(金)		2020年3月14日(土)		2020年3月15日(日)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
31 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」								
31.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」					A301 09:15 ~ 12:15	A301 13:45 ~ 17:15		
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域	PB1 09:30 ~ 11:30	B409 13:15 ~ 17:15						
1.2 教育					PA1 09:30 ~ 11:30			
1.3 新技術・複合新領域			PA1 09:30 ~ 11:30	D209 13:15 ~ 15:30				
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境			PB1 09:30 ~ 11:30	A403 13:15 ~ 16:45				
1.5 計測技術・計測標準	PB2 09:30 ~ 11:30	B408 13:30 ~ 16:00						
1.6 超音波						D311 13:30 ~ 15:30	PA1 09:30 ~ 11:30	D305 13:15 ~ 16:45
2 放射線								
2.1 放射線物理一般・検出器基礎			D209 09:30 ~ 11:30		D511 09:15 ~ 11:45	D511 13:00 ~ 15:45		
2.2 検出器開発		D209 13:45 ~ 18:15				PA2 16:00 ~ 18:00		
2.3 放射線応用・発生装置・新技術							D209 09:00 ~ 11:45	D511 09:00 ~ 11:45
2.4 加速器質量分析・加速器ビーム分析					D209 09:00 ~ 11:45	D209 13:45 ~ 15:00		
						PA2 16:00 ~ 18:00		
3 光・フォトニクス								
3.1 光学基礎・光学新領域					PB1 09:30 ~ 11:30	B408 13:15 ~ 18:15	B410 09:00 ~ 12:15	
3.2 材料・機器光学						PB1 13:30 ~ 15:30	B414 09:00 ~ 11:45	B414 13:15 ~ 14:15
3.3 情報フォトニクス・画像工学	PA1 09:30 ~ 11:30			B415 13:15 ~ 17:00				
3.4 生体・医用光学					PB2 09:30 ~ 11:30		B309 10:30 ~ 11:45	B309 13:15 ~ 16:00
3.5 レーザー装置・材料	B508 09:00 ~ 12:00	B508 13:15 ~ 16:30		PA1 13:30 ~ 15:30				
CS.1 3.5 レーザー装置・材料、3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェア		B508 16:45 ~ 17:30						
3.6 超高速・高強度レーザー	B415 09:30 ~ 11:30	B415 13:15 ~ 17:15	B415 09:00 ~ 10:15		PB3 09:30 ~ 11:30			
3.7 レーザープロセッシング	B410 09:30 ~ 11:45	B410 13:30 ~ 18:00	B410 09:00 ~ 11:30		PB4 09:30 ~ 11:30			
3.8 光計測技術・機器					B409 09:00 ~ 11:45	B409 13:15 ~ 17:30	PA2 09:30 ~ 11:30	B409 13:15 ~ 15:00
3.9 テラヘルツ全般	B414 09:00 ~ 11:45	PA1 13:30 ~ 15:30	B508 09:00 ~ 11:35	B508 13:15 ~ 19:00				
3.10 光量子物理・技術					B406 09:30 ~ 11:15	B406 13:15 ~ 18:00	PA3 09:30 ~ 11:30	
3.11 フォトニック構造・現象				B401 13:00 ~ 15:30	B415 09:30 ~ 12:00	B415 13:30 ~ 17:50		
				PA7 16:00 ~ 18:00				
CS.2 3.11 フォトニック構造・現象と3.12 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション								B415 13:15 ~ 16:15
CS.3 3.11 フォトニック構造・現象と3.13 半導体光デバイスのコードシェアセッション							B415 09:30 ~ 12:00	
3.12 ナノ領域光科学・近接場光学			B409 09:00 ~ 11:45	B409 13:15 ~ 18:15	B309 09:00 ~ 11:45	B309 13:15 ~ 18:30	PA4 09:30 ~ 11:30	
CS.2 3.11 フォトニック構造・現象と3.12 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション								B415 13:15 ~ 16:15
3.13 半導体光デバイス					B410 09:30 ~ 12:15	PB2 13:30 ~ 15:30		B410 13:15 ~ 16:45
CS.3 3.11 フォトニック構造・現象と3.13 半導体光デバイスのコードシェアセッション							B415 09:30 ~ 12:00	
3.14 光制御デバイス・光ファイバー	B406 10:30 ~ 11:45	B406 13:15 ~ 15:30		PA2 13:30 ~ 15:30				
CS.1 3.5 レーザー装置・材料、3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェア		B508 16:45 ~ 17:30						
3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス						PB3 13:30 ~ 15:30	B508 09:30 ~ 11:45	B508 15:15 ~ 17:00
						B508 15:45 ~ 18:00		
3.16 Optics and Photonics English Session								B508 13:15 ~ 15:00
6 薄膜・表面								
6.1 強誘電体薄膜			PA2 09:30 ~ 11:30		D419 09:00 ~ 12:15		D419 09:00 ~ 12:15	
CS.4 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア						A303 13:45 ~ 17:30		
6.2 カーボン系薄膜				PA8 16:00 ~ 18:00	D221 09:00 ~ 12:15	D221 13:45 ~ 18:15	D221 10:30 ~ 12:00	
6.3 酸化物エレクトロニクス		D411 13:45 ~ 17:30	PA3 09:30 ~ 11:30	D411 13:45 ~ 18:15			D311 09:00 ~ 12:15	D311 13:45 ~ 15:45
6.4 薄膜新材料			D221 09:00 ~ 12:15	D221 13:45 ~ 18:30			PB1 09:30 ~ 11:30	
6.5 表面物理・真空					D411 10:00 ~ 12:00	D519 13:30 ~ 16:00		
						PB6 16:00 ~ 18:00		
6.6 プローブ顕微鏡				D519 13:45 ~ 17:00	PB5 09:30 ~ 11:30		D305 09:00 ~ 11:30	

日程表（分科別Ⅲ）

大分類分科名 中分類分科名	2020年3月12日(木)		2020年3月13日(金)		2020年3月14日(土)		2020年3月15日(日)		
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
7 ビーム応用									
7.1 X線技術		PA2 13:30 ~ 15:30			B508 09:00 ~ 12:00				
7.2 電子ビーム応用							D215 09:00 ~ 12:15		
7.3 微細パターン・微細構造形成技術								D215 13:45 ~ 16:45	
7.4 量子ビーム界面構造計測 (※9.5 新機能材料・新物性のコードセッション)					D215 09:30 ~ 11:45	D215 13:45 ~ 15:45			
7.5 イオンビーム一般					D305 09:15 ~ 12:00				
7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術									
8 プラズマエレクトロニクス									
8.1 プラズマ生成・診断		A302 13:15 ~ 18:00				PB4 13:30 ~ 15:30	PB2 09:30 ~ 11:30		
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理		A205 13:45 ~ 18:00	A205 09:00 ~ 10:30						
8.3 プラズマナノテクノロジー				D311 09:00 ~ 10:15					
CS.6 8.3 プラズマナノテクノロジーと9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシートと 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードセッション		D511 13:45 ~ 17:15							
8.4 プラズマライフサイエンス			A201 09:00 ~ 11:30		A304 09:00 ~ 11:30				
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野								A304 09:00 ~ 11:45	A304 13:15 ~ 15:00
8.6 Plasma Electronics English Session					D311 10:30 ~ 12:00	PB4 13:30 ~ 15:30	PB2 09:30 ~ 11:30		
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			A205 10:45 ~ 11:15						
9 応用物性									
9.1 誘電材料・誘電体			D519 09:00 ~ 11:45		D519 09:00 ~ 11:00	PB5 13:30 ~ 15:30			
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート			D305 09:00 ~ 11:45	D305 13:45 ~ 18:15	PA2 09:30 ~ 11:30				
CS.6 8.3 プラズマナノテクノロジーと9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシートと 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードセッション		D511 13:45 ~ 17:15							
9.3 ナノエレクトロニクス	D311 10:00 ~ 11:30	D311 13:30 ~ 16:00	PA4 09:30 ~ 11:30						
9.4 熱電変換	D221 09:00 ~ 11:45	D221 13:00 ~ 15:30	D511 09:00 ~ 12:15						
9.5 新機能材料・新物性		PA4 16:00 ~ 18:00			PA3 09:30 ~ 11:30				
CS.5 7.4 量子ビーム界面構造計測、9.5 新機能材料・新物性のコードセッション					D215 09:30 ~ 11:45	D215 13:45 ~ 15:45			
10 スピントロニクス・マグネティクス									
CS.7 10.1 新物質・新機能創生（作成・評価技術）、10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術、10.3 スピンドバイス・磁気メモリ・ストレージ技術、 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関のコードセッション						A501 15:45 ~ 19:00			
10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）						PA1 13:30 ~ 15:30	A501 09:00 ~ 12:30		
10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術					A501 09:00 ~ 12:30				
10.3 スピンドバイス・磁気メモリ・ストレージ技術			A501 10:00 ~ 12:00						
10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関		A501 13:15 ~ 17:45							
10.5 磁場応用								A202 13:45 ~ 17:00	
11 超伝導									
11.1 基礎物性		PA3 13:30 ~ 15:30	B406 09:00 ~ 11:45	B408 13:15 ~ 17:45					
11.2 薄膜，厚膜，テープ作製プロセスおよび結晶成長				B407 09:00 ~ 12:00					
11.3 臨界電流，超伝導パワー応用					B406 13:15 ~ 16:45				
11.4 アナログ応用および関連技術					B407 13:15 ~ 16:00	B407 09:00 ~ 11:45			
11.5 接合，回路作製プロセスおよびデジタル応用				B408 09:00 ~ 11:15		B408 09:00 ~ 11:45			
11.6 量子デバイス									
12 有機分子・バイオエレクトロニクス									
12.1 作製・構造制御	PB3 09:30 ~ 11:30	A404 13:15 ~ 16:30		A404 13:15 ~ 16:45					
12.2 評価・基礎物性	A405 09:00 ~ 12:00	A405 13:15 ~ 18:00	A405 09:00 ~ 12:00	A405 13:15 ~ 18:00	PB6 09:30 ~ 11:30				
12.3 機能材料・萌芽的デバイス			A410 09:30 ~ 11:30		A408 09:30 ~ 11:30	PB7 16:00 ~ 18:00	A408 09:15 ~ 11:45	A408 13:15 ~ 16:30	
12.4 有機EL・トランジスタ	A409 09:15 ~ 11:45	A409 13:15 ~ 17:15	A409 09:00 ~ 11:30	A409 13:15 ~ 17:30	A409 09:00 ~ 11:00				
12.5 有機太陽電池		PA5 16:00 ~ 18:00							
12.6 ナノバイオテクノロジー	A407 09:00 ~ 12:00	A402 13:15 ~ 18:00	A402 09:00 ~ 11:45	PA3 13:30 ~ 15:30	A402 09:00 ~ 11:45		A402 09:00 ~ 11:45	A402 13:15 ~ 16:15	
12.7 医用工学・バイオチップ	A408 09:00 ~ 12:15	A408 13:15 ~ 15:30	A408 09:00 ~ 12:15	A407 09:00 ~ 11:45	A408 09:00 ~ 11:45				
		PA7 16:00 ~ 18:00							

日程表（分科別Ⅳ）

大分類分科名 中分類分科名	2020年3月12日(木)		2020年3月13日(金)		2020年3月14日(土)		2020年3月15日(日)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 半導体								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	A202 10:00 ~ 11:45	A202 13:15 ~ 16:45		PA4 13:30 ~ 15:30				
13.2 探索的材料物性・基礎物性					A202 09:00 ~ 11:00	PB8 16:00 ~ 18:00	A202 09:00 ~ 11:00	
13.3 絶縁膜技術					PA4 09:30 ~ 11:30		A305 09:00 ~ 12:30	
CS.4 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア						A303 13:45 ~ 17:30		
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術					A305 09:00 ~ 12:00	A305 13:45 ~ 17:30	PB3 09:30 ~ 11:30	A305 13:45 ~ 16:30
13.5 デバイス/配線/集積化技術	PB4 09:30 ~ 11:30	A305 13:45 ~ 17:15	A305 09:00 ~ 11:15	A305 13:45 ~ 17:45				
CS.4 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェア						A303 13:45 ~ 17:30		
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	D511 09:30 ~ 12:15		PA5 09:30 ~ 11:30					
CS.6 8.3 プラズマナノテクノロジーと9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシートと13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェア		D511 13:45 ~ 17:15						
13.7 化合物及びバワー電子デバイス・プロセス技術		B401 13:15 ~ 17:30	B401 09:00 ~ 11:45	PA9 16:00 ~ 18:00	B401 09:00 ~ 12:00	B401 13:30 ~ 18:15		
13.8 光物性・発光デバイス		A303 13:45 ~ 17:45	A303 09:30 ~ 11:30	PA10 16:00 ~ 18:00	A303 09:30 ~ 11:15			
13.9 化合物太陽電池			A202 09:00 ~ 12:00	A202 13:30 ~ 18:00	PA5 09:30 ~ 11:30			
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長	A201 10:00 ~ 12:15	A201 13:45 ~ 17:00				PB9 16:00 ~ 18:00		
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶			D215 09:00 ~ 10:45					
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	D215 09:30 ~ 11:45	D215 14:00 ~ 17:30		PA5 13:30 ~ 15:30				
15.4 III-V族窒化物結晶	A302 09:00 ~ 12:15		A302 09:00 ~ 12:00	A302 13:30 ~ 16:15	A302 09:00 ~ 12:30	A302 13:45 ~ 18:45	A302 09:00 ~ 12:15	A302 13:45 ~ 17:00
				PB1 16:00 ~ 18:00				
15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	D519 10:00 ~ 12:15	D519 13:45 ~ 16:15		PA6 13:30 ~ 15:30				
15.6 IV族系化合物 (SiC)			PA6 09:30 ~ 11:30		A410 09:00 ~ 11:45		A201 09:00 ~ 11:30	A201 13:00 ~ 17:00
15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥						PB10 16:00 ~ 18:00	D411 09:00 ~ 12:00	D411 13:45 ~ 15:00
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス			PB2 09:30 ~ 11:30		A407 09:15 ~ 11:30	A407 13:15 ~ 16:30		
16.2 エナジーハーベスティング	PB5 09:30 ~ 11:30	A407 13:15 ~ 14:15						
16.3 シリコン系太陽電池		A403 13:15 ~ 17:30	A403 09:15 ~ 11:45		A403 09:15 ~ 11:45		PB4 09:30 ~ 11:30	
17 ナノカーボン								
17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料			A404 09:30 ~ 11:45				A403 09:00 ~ 12:00	A403 13:15 ~ 14:45
17.2 グラフェン	PA2 09:30 ~ 11:30	A401 17:45 ~ 18:15	A401 09:00 ~ 11:45		A404 09:00 ~ 09:30	A403 13:45 ~ 18:45		
						A404 13:45 ~ 16:15		
17.3 層状物質		A401 16:15 ~ 17:45			A404 09:30 ~ 11:45	A404 16:30 ~ 19:00	A404 09:00 ~ 11:45	
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」								
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	D419 09:00 ~ 12:15	D419 13:45 ~ 17:45	D419 09:00 ~ 12:15	D419 13:45 ~ 18:15			PA5 09:30 ~ 11:30	
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」								
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」			PB3 09:30 ~ 11:30		A405 09:45 ~ 11:45	A405 13:15 ~ 17:30	A405 09:45 ~ 11:45	
23 合同セッションN「インフォマティクス応用」								
23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」			PB4 09:30 ~ 11:30		A205 09:30 ~ 12:15	A205 13:45 ~ 16:45	A205 09:30 ~ 12:15	